

BT200N1K2T10P 型绝缘栅双极型晶体管

1 特性

- 开关速度快，驱动功率小，饱和压降低；
- 安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1B；
- 封装形式：TO-264PLUS；
- 焊接条件：波峰焊：260±5℃，焊接时间 10±1s。

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ 1038QZ	G+：Q/RBJ 1038QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级：Q/RBJ-GL-02JS	

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	I_C ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) (A)	P_C^a ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) (W)	V_{GE} (V)	$V_{(BR)CES}$ (V)	$R_{th(j-c)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)	T_J ($^{\circ}\text{C}$)	T_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)
BT200N1K2T10P	200	300	±20	1200	0.42	-55~150	-55~150

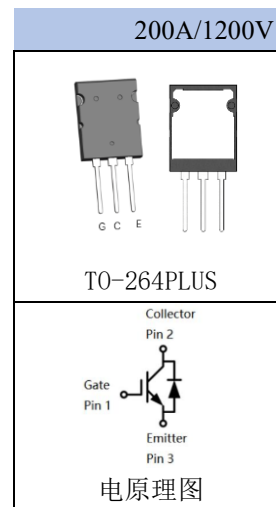
^a $T_C \geq 25^{\circ}\text{C}$ 时，按 2.4W/ $^{\circ}\text{C}$ 线性降额。

4 主要电特性

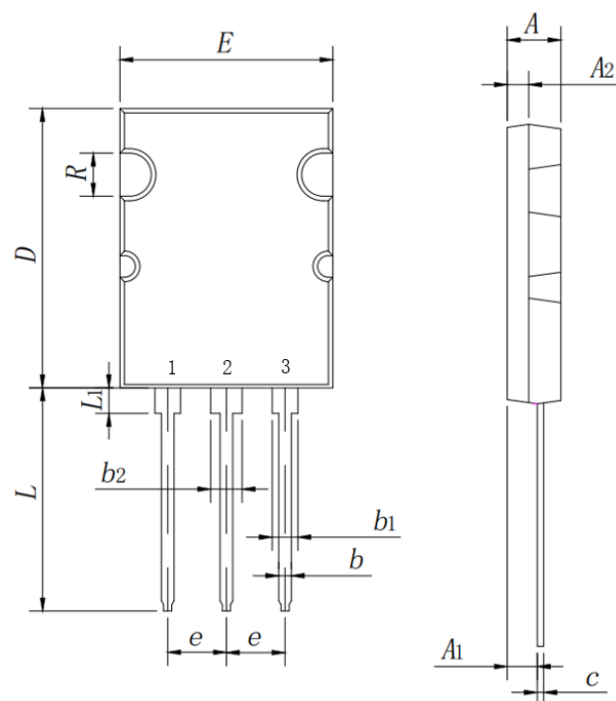
主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
1	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0\text{V}$, $I_C=1\text{mA}$	1200	—	V
2	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}$, $V_{GE}=0\text{V}$	—	10	μA
3	I_{GES}	$V_{GE}=20\text{V}$, $V_{CE}=0\text{V}$	—	100	nA
4	$V_{GE(th)}$	$V_{CE}=V_{GE}$, $I_C=2.6\text{mA}$	5.1	6.3	V



5 外形尺寸



引出端：1-栅极 G，2-集电极 C，3-发射极 E

单位:mm

符号 尺寸	A	A_1	A_2	b	b_1	b_2	c	D	E	e	L	L_1	R
最小值	4.70	2.45	1.90	1.00	2.20	2.75	0.50	25.75	19.50	5.37	19.90	2.10	3.70
最大值	5.30	2.95	2.25	1.35	2.75	3.20	0.85	26.45	20.25	5.57	20.75	2.70	4.30

图 1 T0-264PLUS 外形尺寸图